

КТ603Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n.

Предназначены для применения в импульсных и переключающих высокочастотных устройствах.

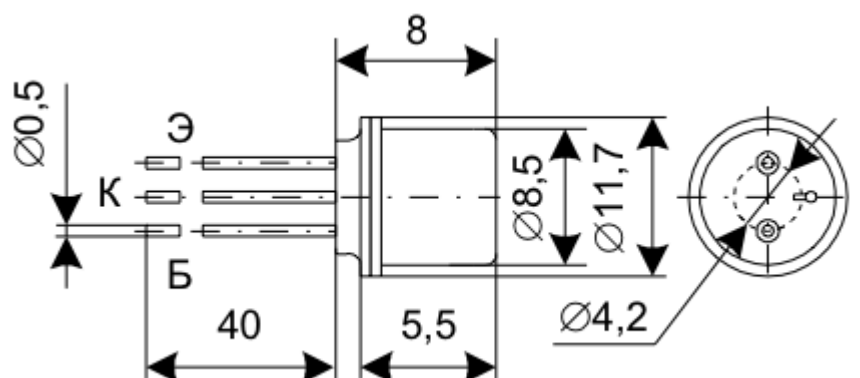
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1,75 г.

Тип корпуса: КТЮ-3-6.

Технические условия: И93.365.003 ТУ.



Основные технические характеристики транзистора КТ603Б:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб}=2$ В, $I_э=150$ мА : не менее 60;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ: не менее 200 МГц;
- t_k - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 400 пс;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кбо} = 30$ В: не более 10 мкА;
- C_k - Емкость коллекторного перехода: не более 4 пФ;
- $U_{кб}(U_{кэр})_{max}$ – Максимальное постоянное (импульсное) напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 1$ кОм: 30 В;
- $U_{эб max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база: 3 В;
- $I_k max$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 300 мА;
- $I_k и max$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора при $t_i \leq 10$ мкс: 600 мА;
- $P_k max$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 0,5 Вт;
- t_p - Температура p-n перехода: не более 120°C;
- $t_{окр}$ – Температура окружающей среды: -60...+125°C.